

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成23年10月13日 (2011.10.13)

【公開番号】特開2010-56423(P2010-56423A)

【公開日】平成22年3月11日 (2010.3.11)

【年通号数】公開・登録公報2010-010

【出願番号】特願2008-221899(P2008-221899)

【国際特許分類】

H 0 1 L 33/36 (2010.01)

H 0 1 L 33/32 (2010.01)

H 0 1 S 5/042 (2006.01)

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 33/00 E

H 0 1 L 33/00 C

H 0 1 S 5/042 6 1 2

H 0 1 L 21/28 3 0 1 R

H 0 1 L 21/28 3 0 1 B

【手続補正書】

【提出日】平成23年8月29日 (2011.8.29)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

$A_{1-x}Ga_yIn_{1-x-y}N$  ( $0 \leq x \leq 1$ 、 $0 \leq y \leq 1$ 、かつ  $0 \leq x+y \leq 1$ ) の一般式で表される半導体層と接触し、A g を主成分とし P d、C u 及び G e が添加されている A g 合金層を含む半導体発光素子用電極。

【請求項 2】

前記 A g 合金層の P d 及び C u の濃度が 3 質量 % 以下である請求項 1 に記載の半導体発光素子用電極。

【請求項 3】

前記 A g 合金層の G e の濃度が 1 質量 % 以下である請求項 2 に記載の半導体発光素子用電極。

【請求項 4】

前記 A g 合金層は、5 2 5 以下で熱処理が施されている請求項 3 に記載の半導体発光素子用電極。

【請求項 5】

$A_{1-x}Ga_yIn_{1-x-y}N$  ( $0 \leq x \leq 1$ 、 $0 \leq y \leq 1$ 、かつ  $0 \leq x+y \leq 1$ ) の一般式で表される半導体層と、

請求項 4 に記載の半導体発光素子用電極と、を備えた半導体発光素子。

【請求項 6】

前記半導体層は、サファイア基板上に形成され、

前記半導体発光素子用電極は、前記半導体層における前記サファイア基板と反対側に形成される請求項 5 に記載の半導体発光素子。